# Микросхемы интегральные 1638РР1АУ, 1638РР1БУ, 1638РР1ВУ

### Функциональное назначение микросхемы

Микросхема энергонезависимой многократно электрически перепрограммируемой ПЗУ (ЭСППЗУ) с параллельным вводом/выводом информации (128Кх8).

#### Конструктивное исполнение

Микросхемы изготавливаются в металлокерамических корпусах с золотым покрытием выводов H14.42.

# **Нумерация, обозначение и назначение выводов** микросхемы

Номер вывода	Обозначение	Назначение выводов	
1	NC	Свободный вывод	
2	A16	Вход адреса	
3	A15	Вход адреса	
4	A12	Вход адреса	
5	A7	Вход адреса	
6	A6	Вход адреса	
7	A5	Вход адреса	
8	A4	Вход адреса	
9-13	NC	Свободный вывод	
14	А3	Вход адреса	
15	A2	Вход адреса	
16	A1	Вход адреса	
17	Α0	Вход адреса	
18	1/00	Вход / выход данных	
19	I/O1	Вход / выход данных	
20	1/02	Вход / выход данных	
21	GND	Общий вывод	
22	1/03	Вход / выход данных	
23	1/04	Вход / выход данных	
24	1/05	Вход / выход данных	
25	1/06	Вход / выход данных	
26	1/07	Вход / выход данных	
27	CE	Вход разрешения	
28	A10	Вход адреса	
29	ŌĒ	Вход разрешения выхода	
30-33	NC	Свободный вывод	
34	A11	Вход адреса	
35	А9	Вход адреса	
36	A8	Вход адреса	
37, 38	NC	Свободный вывод	
39	A13	Вход адреса	
40	A14	Вход адреса	
41	WE	Вход разрешения записи (считывания)	
42	V <sub>cc</sub>	Вывод питания от источника напряжения	

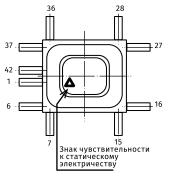
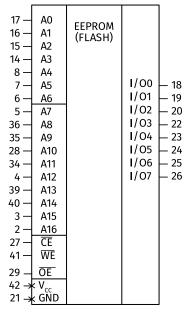


Схема расположения выводов



Условное графическое обозначение



## Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра,	Буквенное	Норма параметра		
наименование параметра, единица измерения, режим измерения	обозначение параметра	не менее не более		Температура среды, °С
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при U <sub>cc</sub> = 5 В ±10%; I <sub>ot</sub> ≤ 2 мА	U <sub>oL</sub>	-	0,45	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{cc}$ = 5 В ±10% $I_{oH}$ ≤ 0,4 мА $I_{oH}$ ≤ 0,1 мА	U <sub>oh</sub>	2,4 (U <sub>cc</sub> -0,3)	_	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
3 Ток потребления в режиме хранения при ТТЛ-	I <sub>ccs1</sub>	(O <sub>CC</sub> 0,3)	3	25 ±10
уровнях на входах, мА при U <sub>cc</sub> = 5 B ±10% и U <sub>ceн</sub> = (2,4 – 2,6) В		-	5	-60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
4 Ток потребления в режиме хранения при КМОП-у-	I <sub>CCS2</sub>	-	100	25 ±10
ровнях на входах, мкА при U <sub>CC</sub> = 5 B ±10% и U <sub>CEH</sub> = [(U <sub>CC</sub> -0,3) - U <sub>CC</sub> ] В			200	-60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup>
				85
5 Динамический ток потребления в режиме считывания при ТТЛ-уровнях на входах, мА при $U_{cc} = 5$ В ±10%, $U_{ce} = (0,6-0,8)$ В, $U_{ce} = (0,6-0,8)$ В, $U_{ce} = (0,6-0,8)$ В, $U_{ce} = (0,6-0,8)$ В $U_$	I <sub>OCCR</sub>	-	60	25 ±10 -60¹¹, -55²¹, -45³¹ - 85
U <sub>CEH</sub> = (2,4 – 2,6) B, t <sub>CYR</sub> ≥ 250 нс и C <sub>L</sub> ≤ 100 пФ <sup>4)</sup> 6 Ток утечки высокого и низкого уровня на входе,		_	1	25 ±10
мкА при $U_{cc}$ = 5 B ±10%	I <sub>ILH</sub> , I <sub>ILL</sub>		10	-60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
7 Выходной ток высокого и низкого уровня в состо-			10	25 ±10
янии «Выключено» по выводам вход выход, мкА при $U_{\rm CC}$ = 5 B ±10%	I <sub>I/OZH</sub> , I <sub>I/OZL</sub>		20	-60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
8 Время выборки разрешения, нс при $\rm U_{\rm CC}$ = 5 В ±10%, $\rm t_{\rm CVR}$ $\geq$ 120 нс и $\rm C_{\rm L}$ $\leq$ 100 п $\rm \Phi^{\rm 4)}$	t <sub>ACE</sub>	-	120	25 ±10 -60¹¹, -55²¹, -45³¹ – 85
9 Время выборки адреса, нс при $U_{cc}$ = 5 В ±10%, $t_{CVR}$ ≥ 120 нс и $C_L$ ≤ 100 п $\Phi^{4)}$	t <sub>AA</sub>	-	120	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
10 Время цикла записи страницы (128 байт), мс при U <sub>cc</sub> = 5 B ±10%	t <sub>cyw</sub>	10	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
11 Время цикла считывания, нс при $U_{cc}$ = 5 В ±10% и $C_{c}$ $\leq$ 100 п $\Phi^{(4)}$	t <sub>CYR</sub>	120	-	25 ±10 -60¹¹, -55², -45³¹ – 85
13 Время выхода из цикла загрузки байта, мкс при U <sub>cc</sub> = 5 B ±10%	t <sub>CYBLCO</sub>	200	-	25 ±10 -60¹¹, -55², -45³¹ – 85
14 Время установления сигнала WE или СЕ после сигнала адреса, нс	t <sub>SUAWEL</sub> , t <sub>SUACEL</sub>	0	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
15 Время удержания сигнала адреса после сигнала $\overline{\text{WE}}$ или $\overline{\text{CE}}$ , нс	t <sub>HWELA</sub> , t <sub>HCELA</sub>	50	_	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
16 Время установления сигнала $\overline{\text{WE}}$ после сигнала $\overline{\text{CE}}$ , нс	t <sub>sucelwel</sub>	0	_	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
17 Время удержания сигнала $\overline{\text{CE}}$ после сигнала $\overline{\text{WE}}$ , нс	t <sub>HWEHCEL</sub>	0	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
18 Время установления сигнала WE или CE после сигнала ОE, нс	t <sub>SUOEHWEL</sub> t <sub>SUOEHCEL</sub>	10	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
19 Время удержания высокого уровня по сигналу ОЕ после сигнала WE или СЕ, нс	t <sub>HWEHOEH</sub> , t <sub>HCEHOEH</sub>	10	_	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
20 Длительность импульса по низкому уровню сигнала $\overline{\text{WE}}$ или $\overline{\text{CE}}$ при записи, нс	t <sub>wwelw</sub> , t <sub>wcelw</sub>	70	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
21 Длительность импульса по высокому уровню сигнала $\overline{\text{WE}}$ или $\overline{\text{CE}}$ при записи, нс	t <sub>wwehw</sub> , t <sub>wcehw</sub>	150	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
22 Время удержания сигнала $\overline{\text{WE}}$ или $\overline{\text{CE}}$ после сигнала входной информации, нс	t <sub>HDIWEL</sub> , t <sub>HDICEL</sub>	50	_	25 ±10 -60¹¹, -55²¹, -45³¹ – 85
23 Время удержания сигнала входной информации после сигнала WE или CE, нс	t <sub>HWEHDI</sub> , t <sub>HCEHDI</sub>	10	_	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
24 Дл <u>ите</u> льность импульса по низкому уровню сигнала СЕ при считывании, нс	t <sub>wcelr</sub>	120	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
25 Дл <u>ите</u> льность импульса по низкому уровню сигнала ОЕ при считывании, нс	t <sub>woelr</sub>	60	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
26 Время удержания сигнала CE после сигнала адреса, нс	t <sub>hacel</sub>	0	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
27 Время удержания сигнала OE после сигнала CE при считывании, нс	t <sub>HCEHOELR</sub>	0	-	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> – 85
28 Время нарастания и спада входных сигналов, нс	t <sub>LH</sub> , t <sub>HL</sub>	-	10	25 ±10 -60 <sup>1)</sup> , -55 <sup>2)</sup> , -45 <sup>3)</sup> - 85
1) TORKKO REG MAKROCKOM 1629 DD1AV				-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Только для микросхем 1638PP1AУ. <sup>2)</sup> Только для микросхем 1638PP1БУ. <sup>3)</sup> Только для микросхем 1638PP1BУ. <sup>4)</sup> С учетом всех паразитных емкостей

## Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Параметр	Ед. изм.	Предельно допустимый
Напряжение питания	В	4,5 - 5,5
Рабочая температура среды	°C	от -60 до +85
Предельная температура среды	°C	от -60 до +150
Число циклов перезаписи	-	10 000